

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

公告编号：2026-012

# 浙江晶盛机电股份有限公司

## 2025 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,309,533,797 股扣除已回购股份 2,173,984 股后的 1,307,359,813 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	晶盛机电	股票代码	300316
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陆晓雯	季仕才	
办公地址	浙江省杭州市临平区顺达路 500 号	浙江省杭州市临平区顺达路 500 号	
传真	0571-89900293	0571-89900293	
电话	0571-88317398	0571-88317398	
电子信箱	jsjd@jsjd.cc	jsjd@jsjd.cc	

## 2、报告期主要业务或产品简介

### (一) 公司主营业务、主要产品及用途

公司始终坚持先进材料、先进装备双引擎可持续发展的战略定位，形成了装备+材料协同发展的良性产业布局，主营业务产品涉及半导体装备、半导体衬底材料以及半导体耗材及零部件领域。

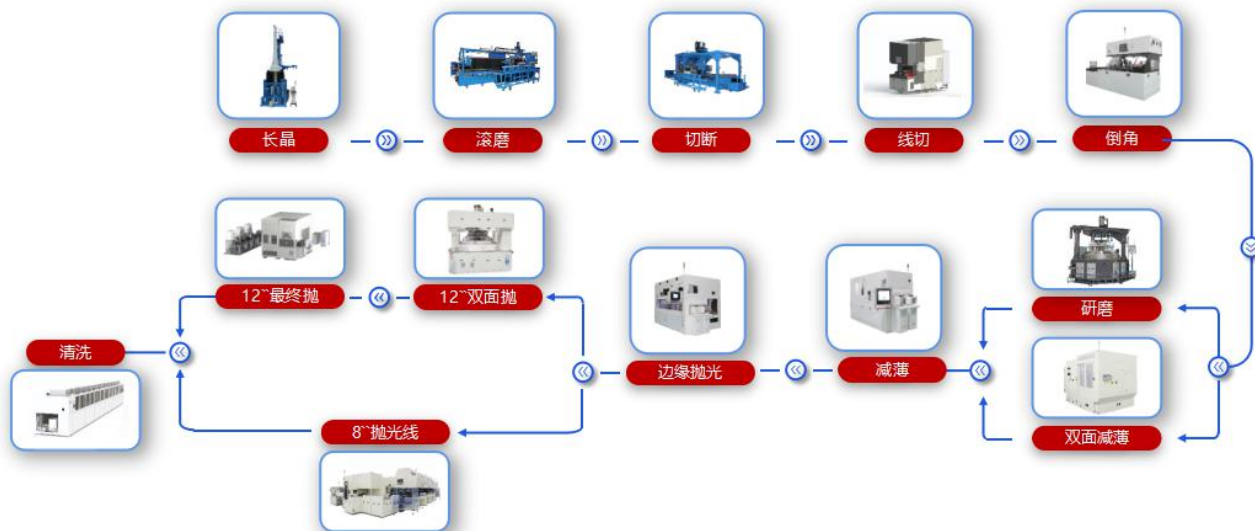


图一 公司主营业务布局

### 1、半导体装备

#### (1) 半导体集成电路装备

硅片制造端，公司实现了 8-12 英寸半导体大硅片设备的国产替代，开发出了包括全自动晶体生长设备（直拉单晶生长炉、区熔单晶炉）、晶体加工设备（单晶硅滚圆机、截断机、金刚线切片机等）、晶片加工设备（晶片倒角机、研磨机、减薄机、抛光机）以及外延设备和清洗设备，且均已实现批量销售，其中长晶设备在国产设备市场市占率领先。



图二 大硅片设备产品

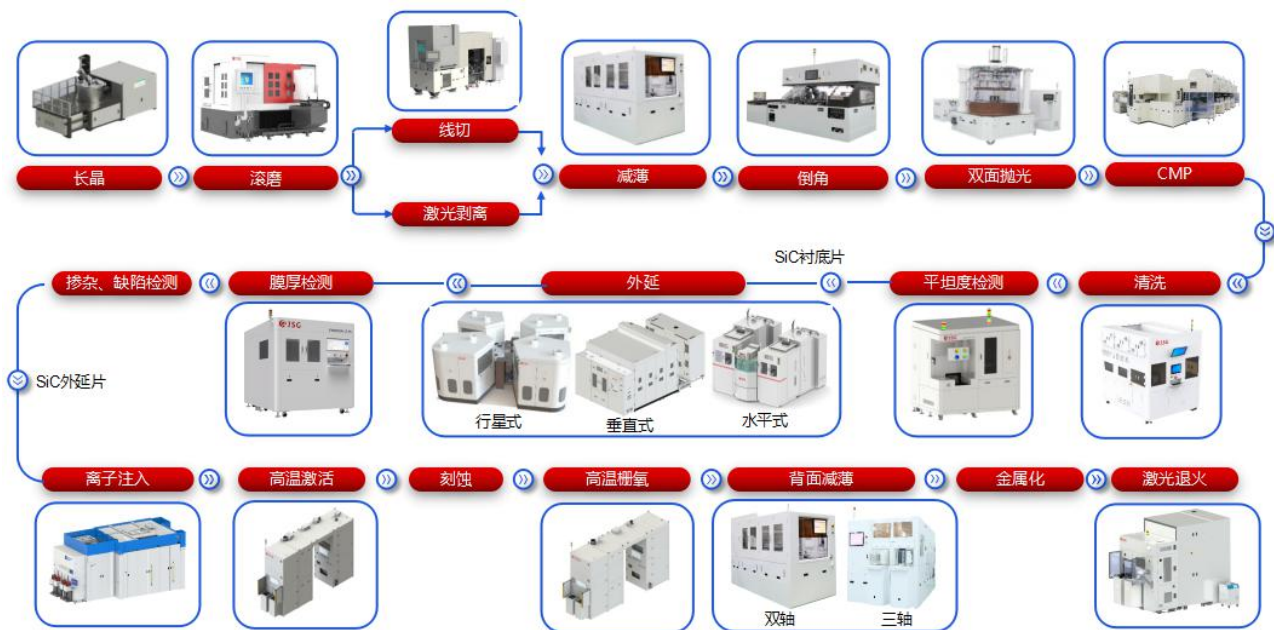
在芯片制造和封装端，公司开发了应用于芯片制造的 8-12 英寸减压外延设备、ALD 设备等薄膜沉积类设备，应用于先进封装的 12 英寸减薄抛光机、12 英寸减薄抛光清洗一体机、超快紫外激光开槽设备。以差异化的工艺和技术优势，为客户提供优质的产品和服务。



图三 先进制程及先进封装设备产品

(2) 化合物半导体装备

碳化硅装备领域，公司开发了碳化硅长晶及加工设备（研磨、切割、减薄、倒角、抛光、清洗及检测），满足碳化硅衬底规模化产能建设需求的同时，在技术、工艺以及成本方面构筑壁垒，强化公司在碳化硅衬底领域的核心竞争力。基于产业链核心设备的国产化突破，在检测、离子注入、激活、氧化、减薄、退火等工艺环节积极布局产品体系，以高标准研发目标，逐步实现产品产业化市场突破，6-8 英寸碳化硅外延设备实现国产替代并市占率领先，率先开发了 12 英寸碳化硅外延设备。在蓝宝石装备领域，公司开发了长晶、切片、研磨、抛光等系列设备，实现设备、工艺的高度融合，促进联合创新，提升公司蓝宝石材料领域的综合竞争力。



图四 碳化硅产业链设备产品

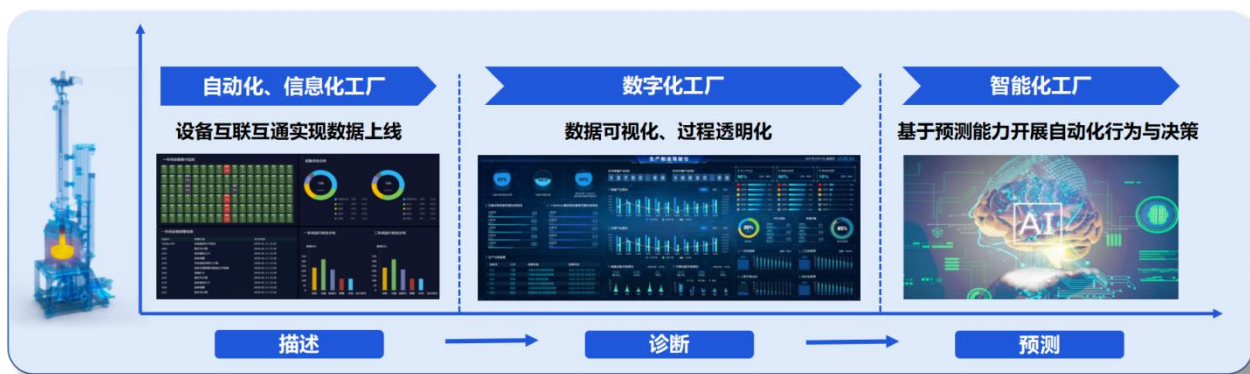
(3) 新能源光伏装备

在光伏装备领域，公司产品覆盖了硅片、电池和组件环节，为客户提供光伏整线解决方案。硅片制造端，公司的主要产品有全自动晶体生长设备（单晶硅生长炉）、晶体加工设备（环线截断机、环形金刚线开方机、滚圆磨面一体机、金刚线切片机）、晶片加工设备（脱胶插片清洗一体机）、晶片分选检测设备等；在电池端，公司开发 PECVD、扩散、退火、单腔室多舟 ALD 和电池切割边缘钝化（EPD）设备等多种电池工艺设备；在组件端，公司开发了含排版机、边框自动上料机、灌胶检测仪等多道工序的组件设备产线。同时，通过实现各装备间的数字化和智能化联通，向客户提供自动化+数字化的智能工厂解决方案，促进客户生产效率提升，实现降本增效。

公司单晶硅生长炉在光伏行业实现了技术和规模双领先，切片机、脱胶插片清洗一体机以及分选装盒一体机以创新的设计和工艺，实现了生产效率和质量的大幅提升；差异化设计和工艺的电池设备，在稳定性、均匀性以及效率等方面表现优异，EPD 设备增效显著，得到客户的广泛认可；创新的去银化组件设备，能够大幅降低电池及组件环节的银耗，大幅降低组件生产成本。



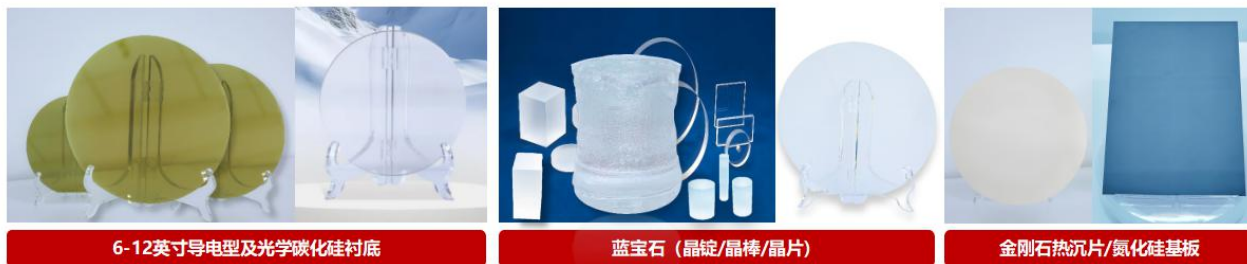
图五 光伏产业链设备产品



图六 智能化解决方案

## 2、半导体衬底材料

公司碳化硅衬底材料已实现 6-8 英寸衬底规模化量产，并实现 12 英寸碳化硅单晶生长技术突破，建设 12 英寸碳化硅衬底中试产线并小规模送样。蓝宝石材料业务取得了全球范围内的技术和规模双领先，已实现 750kg、1000kg 晶锭及 4-8 英寸衬底的规模化量产，并研发出 12 英寸衬底及 310mm 方形衬底。金刚石材料方面，公司依托自研 MPCVD 设备与工艺，建设了大尺寸金刚石生产线，聚焦面向芯片散热的金刚石热沉片及面向光学系统的窗口材料。氮化硅材料方面，公司首条氮化硅陶瓷产线已通线，在高热导率、高可靠性、高表面平整度等核心指标达到国际先进水平，逐步实现高端氮化硅基板的国产化替代，为中国新能源汽车和高端装备产业的发展筑牢材料基石。

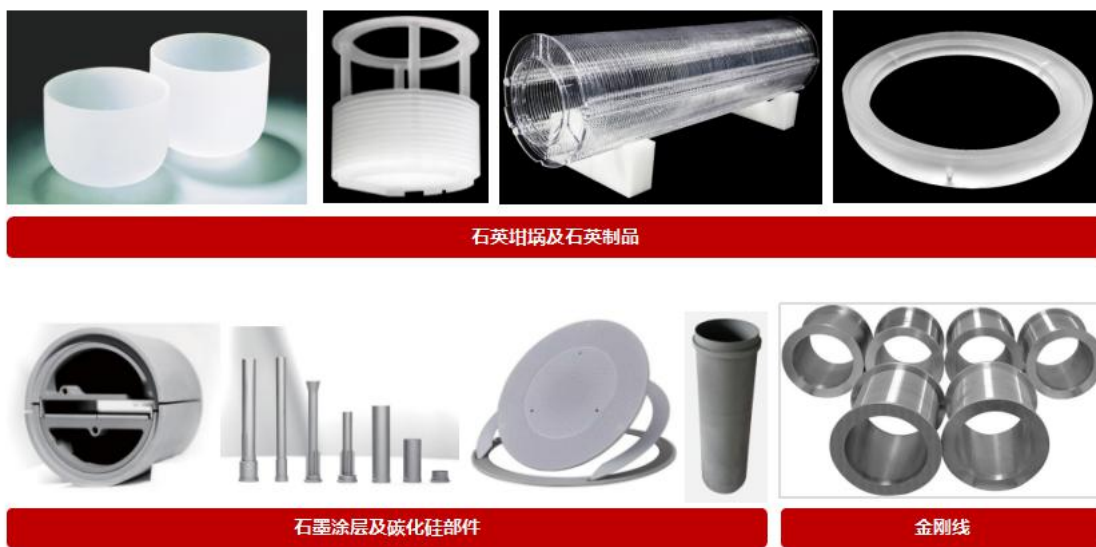


图七 半导体衬底材料产品

3、半导体耗材及零部件

(1) 半导体耗材

公司石英坩埚业务已实现技术与规模的双重领先，可提供全规格、高品质的石英坩埚产品，广泛覆盖半导体及光伏领域应用；其中半导体石英坩埚成功突破海外技术垄断，实现核心环节国产化替代，光伏石英坩埚市占率持续领跑并稳步提升，为双赛道协同发展奠定坚实基础。依托同源超高纯石英材料技术平台、核心生产设备自主研发体系、自动化与智能化生产运营管理体系，以及成熟的半导体级品控标准，公司搭建数字化智能制造产线，保障产品批次一致性与性能稳定性。在此基础上，公司向高端石英制品领域高效延伸，相继开发出适用于半导体晶圆生长、热处理、刻蚀、清洗等关键制程的炉管类、舟类、环类、治具类、清洗类等核心耗材，全面覆盖半导体制造多场景应用需求，显著提升对半导体客户的一站式协同供应能力。伴随高端客户认证的持续突破与市场需求的快速增长，公司石英材料板块中半导体业务占比实现快速提升，进一步强化了在高端半导体石英材料领域的综合竞争力。在石墨制品领域，公司相继拓展了外延基座、碳化硅部件等产品。在金刚线领域，依托电镀金刚线技术自主研发和工艺创新，显著提升切割效率与产品稳定性，实现高品质钨丝金刚线的规模化量产。



图八 公司半导体耗材产品

(2) 半导体精密零部件

公司构建了覆盖高端半导体设备核心部件的全产品体系，涵盖腔体与结构件（传输腔体、反应腔体、真空腔体等）、功能组件（气体分配盘、精密传动装置、磁流体密封装置、超导磁体等）、耗材与密封件（圆环类组件、腔体遮蔽件、半导体阀门管件等）三大核心产品矩阵。通过设备、技术和工艺创新，形成高精密加工、特种焊接技术、半导体级表面处理及全流程集成验证四大核心能力。



图九 公司半导体精密零部件产品

## （二）公司业务所处行业发展情况

### 1、半导体装备

#### （1）集成电路装备领域

半导体设备市场需求随行业周期波动，受 AI 算力驱动的先进制程投资、HBM 存储产能扩张、全球供应链自主化政策共同拉动，在本轮行业复苏周期中呈现高景气增长。据 SEMI 2025 年终最新预测，2025 年全球半导体制造设备销售额预计达 1,330 亿美元，同比增长 13.7%，创历史新高；预计 2026 年、2027 年将稳步攀升至 1,450 亿美元、1,560 亿美元，连续三年保持增长。中国大陆仍是全球最大半导体设备市场。全球半导体设备行业集中度高，先进制程核心设备仍由海外厂商主导垄断；我国设备企业已基本覆盖各细分赛道，整体国产化率持续提升，但量检测、涂胶显影等环节国产化水平仍偏低，核心零部件国产化仍有较大提升空间。

在硅片制造设备环节，目前 8-12 英寸大硅片设备已基本实现国产化。国产设备凭借性能达标、交付与服务响应快、供应链安全可控等优势，在国内主流大硅片产线占据主要份额。在芯片制造设备环节，在政策支持与产业需求驱动下，国内设备生态加速完善，国产化率快速提升，成熟制程设备已形成规模化量产与竞争优势，先进制程设备持续突破，刻蚀、薄膜沉积、清洗等关键环节国产化率显著提升，新建晶圆产线国产设备采购比例持续走高，替代节奏进一步加快。在封装测试设备环节，虽然我国封测产业成熟度高于芯片制造环节，但高端封测设备国产化率仍然较低。伴随国产设备技术突破与自主可控战略推进，中高端封装、测试设备国产化正进入加速渗透期。

#### （2）化合物半导体装备领域

以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等为代表的第三代化合物半导体材料，凭借高击穿电场强度、高导热率、高电子饱和速度及耐腐蚀等优异物理化学特性，成为制备高温、高频、抗辐射及大功率电子器件的核心基础材料，在光电子与微电子领域应用空间持续拓展。当前行业正从技术验证转向规模化商用爆发期，产业技术加速迭代，材料良率提升、成本快速下探，进一步打开产业化空间。

碳化硅材料凭借优异热稳定性与电学性能，已成为新能源汽车 800V 高压平台的核心器件方案，可显著提升电驱效率、延长续航并缩短充电时间；同时在 AI 数据中心高压电源、光伏逆变器、储能 PCS、工业电源及轨道交通等领域也呈现出快速渗透的态势。

随着 SiC 产能快速扩张、8 英寸产线建设提速以及下游新能源与 AI 算力需求持续释放，化合物半导体行业市场规模保持高速增长，碳化硅衬底、外延、刻蚀、薄膜、清洗、量检测等专用装备需求同步快速攀升，成为半导体设备领域重要增量赛道。

#### （3）新能源光伏装备领域

根据国家能源局数据，2025 年，我国新增光伏装机量达 316.57GW，同比增长 14%。CPIA 预测全球新增装机 570-630GW，同比增长约 20%。当前光伏行业已进入规模化与高质量发展并重的阶段，市场竞争日趋激烈，发展模式正从单

纯依靠规模扩张逐步转向以技术提效为核心的竞争新格局。以 N 型 TOPCon、XBC 等高效电池技术迭代为牵引，叠加去银化、薄片化等工艺升级，更高效率与智能化水平的专用设备成为提效核心引擎。数字化与智能化生产模式的普及，为行业提供了系统性解决方案，通过打造高效智能工厂，实现设备运行、生产流程与管理体的全链路数字化协同，可有效突破传统生产效率瓶颈，显著提升产品良率与人均产出。这一模式正支撑光伏产业在成本与毛利双重压力下，实现从“规模为王”向“能效领先+技术创新”的高质量转型。

## 2、半导体衬底材料

作为半导体产业链的上游环节，半导体材料具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高等特点，对产业发展起到重要支撑作用。公司业务涉及化合物半导体材料碳化硅衬底和蓝宝石衬底，以及超宽禁带半导体材料金刚石材料。

### (1) SiC 衬底材料

碳化硅 (SiC) 作为第三代半导体材料的核心代表，凭借高击穿电场强度、高导热率、低导通损耗等优异特性，已成为支撑高端制造业升级的战略基石。导电型碳化硅功率器件能完美适配高压、高温、高频工作环境，在新能源汽车 800V 高压平台、AI 数据中心高压电源、光伏储能逆变器、轨道交通及特高压输电等场景实现规模化应用。半绝缘型碳化硅则依托低载流子浓度与优异微波损耗特性，成为 5G-A/6G 基站射频前端、低轨卫星通信等的核心衬底材料，其高折射率、高硬度的光学特性，在 AR 眼镜等光学显示终端应用领域有着不可替代的优势。

据 Yole Group 预测，2025 年全球的 SiC 衬底市场规模约为 30.5 亿美元，同比增长 28.7%，预计 2026 年将达到 38 亿美元。国内碳化硅产业链在技术创新和资本加持下实现跨越式发展，衬底片市场正加速形成 8 英寸规模化量产与 12 英寸前瞻布局并行的双轨格局。在功率器件端，8 英寸碳化硅衬底片凭借更高的使用效率和更优的缺陷指标，有效降低产业链综合制造成本，正加速推动产能向 8 英寸切换；随着 8 英寸技术生态的成熟，碳化硅功率器件在下游领域的渗透步伐将进一步加快。与此同时，12 英寸碳化硅衬底片瞄准 AR 设备、CoWoS 先进封装基板等新兴应用领域，正积极开拓更具想象的市场空间。当前，全球碳化硅产业生态持续优化，规模化降本持续推进，新应用场景不断涌现，叠加下游需求加速释放，碳化硅产业正告别“野蛮生长”，进入以技术壁垒与生态整合为核心的高质量发展阶段，市场空间有望持续扩大。

### (2) 蓝宝石衬底材料

蓝宝石材料凭借与 GaN 晶格匹配好、强度大、硬度高、耐腐蚀等特点，被广泛应用于 LED 衬底、消费电子视窗盖板及光学部件等领域，其中 LED 行业和消费电子是蓝宝石材料的主要应用领域。近年来，蓝宝石材料应用市场呈现复苏，传统 LED 照明的二次替换需求增长，Mini/Micro LED、5G 射频、功率半导体 (GaN-on-Sapphire) 及消费电子光学部件等新兴领域的需求成为核心增量，车载 Mini LED 显示屏等场景增速显著，据 TrendForce 集邦咨询数据预测，2026 年全球 LED 芯片及封装产业产值预计达 121.76 亿美元，年增 3.4%。供给端方面，随着长晶及加工的技术和工艺进步，蓝宝石尺寸不断扩大，成本持续降低，推动其应用领域向更多细分市场延伸。

### (3) 金刚石材料

金刚石以其优异的物理特性在工业、半导体、珠宝等领域有着广泛应用。作为当前单质半导体材料中带隙最宽的材料，金刚石兼具高击穿电场、大饱和载流子速度、高载流子迁移率和低介电常数等卓越电学性质，更拥有自然界最高热导率，是制备下一代高功率、高频、高温及低功率损耗电子器件的理想材料，被称为第四代半导体材料。CVD 金刚石凭借散热性强、尺寸可控、成本持续优化的优势，可作为大功率散热片，已从实验室验证阶段迈向规模化应用初期，未来随着大尺寸晶圆缺陷控制技术的进步和制备成本的不断下降，有望在半导体散热领域得到大规模应用。金刚石衬底材料市场正处于“技术突破-场景验证-量产爬坡”的关键阶段。随着量子计算、6G 通信等新兴领域对超高热导率材料需求的逐步释放，市场规模有望进入快速增长周期。

### (4) 氮化硅陶瓷材料

氮化硅陶瓷因其出色的机械强度、卓越的抗热震性、与半导体芯片匹配的热膨胀系数，以及优异的绝缘性和可金属化能力，被视为极端工况下不可替代的关键材料，广泛应用于新能源汽车电控系统、5G/6G 通信射频器件、光伏与储能逆变器、轨道交通与智能电网等高精尖领域。目前，高性能氮化硅陶瓷材料的制备技术和主要市场份额仍被日本等国外企业主导，随着新能源汽车及半导体设备领域市场需求的持续释放，高性能氮化硅陶瓷材料的国产化进程将持续提速。

## 3、半导体耗材及零部件

### (1) 半导体耗材领域

半导体耗材作为半导体制造过程中不可或缺的消耗品，在整个半导体产业链中占据关键地位。伴随全球半导体产业持续扩张，在 AI 芯片、先进制程与 HBM 需求拉动下，耗材市场规模增速进一步提升。其中，石英坩埚、石英制品、石墨制品和金刚线等作为半导体及光伏产业的核心生产耗材，深度渗透硅片制造、芯片制造以及光伏硅片、电池片制造等关键环节。据 QYResearch 报告数据，2025 年全球石英制品市场规模达 140.3 亿美元，预计 2026 至 2032 年期间年均复合增长率为 5%；其中半导体用石英部件增速尤为突出，2025 年市场规模约 59.5 亿元人民币，2026 至 2032 年复合增长率达 9.2%。

我国石英材料产业正经历从“替代跟随”到“创新引领”的关键转折。在半导体领域，国产石英坩埚凭借大尺寸技术突破和供应链协同，逐步打破海外垄断，实现国产化替代；随着国内 12 英寸晶圆厂扩产加速，半导体用高纯石英、大口径石英管/腔体需求快速放量，本土石英零部件企业在国内晶圆厂供应占比持续提升。石英制品品类多元，几乎贯穿半导体晶圆制造全流程。随着先进制程工艺演进，行业对石英制品的纯度、热稳定性和尺寸精度要求愈发严苛，国内石英制品企业持续加大研发投入，通过技术创新提升产品质量，并深化与国内半导体制造企业的协同合作，实现产业联动发展，推动国产石英制品在高端市场的占有率持续提升。

石墨制品作为硅片长晶、外延、刻蚀环节的关键耗材，随着 8 英寸 SiC 产线规模化落地，半导体高端石墨市场需求快速提升。国内企业在等静压高纯石墨领域实现关键突破，产品关键指标已达国际先进水平，国产部件在成本、交货期、本地化服务等方面优势明显，已批量进入头部 SiC 厂商供应链，高端石墨制品国产化进入放量阶段。

作为硅棒截断与硅片切割的核心耗材，金刚线的性能直接关乎硅片质量、效率和成本。钨丝金刚线凭借耐磨损、高强度、断线率低、细线化等优势，在光伏产业市场渗透率持续提升，已逐步替代碳钢金刚线成为主流。

## （2）半导体零部件领域

半导体精密零部件以微米级精度、超千种细分品类、高耐腐蚀性（适应高频等离子体/强真空环境）构筑技术壁垒，覆盖刻蚀机反应腔体、沉积设备气体分配盘（Showerhead）、石墨涂层载具、石英及陶瓷部件等。作为支撑半导体装备制造运行的核心基础单元，半导体设备零部件具备高精密、高洁净度、超强耐腐蚀能力及优异电气绝缘性能，其生产制造深度融合精密机械加工、特种工程材料研发、表面处理工艺创新、机电系统集成及高端工程设计等多学科技术体系，部分先进制程零部件要求达到纳米级加工精度与 ppm 级杂质控制水平。根据 QYResearch 报告数据，2025 年全球半导体零部件（核心机械/结构备件，含腔体、轴、夹具等）市场规模达 315.3 亿美元，预计 2026–2032 年以 7.8% 的年复合增长率增长。中国作为最大的区域市场，占全球份额约 30%，预计 2026–2032 年复合增长率达 9.0%。

半导体设备精密零部件种类繁多，当前国内尚未形成高度集中的市场格局，主要由美国、日本和欧洲企业主导。受国际贸易政策及供应链安全诉求驱动，国产替代成为行业迫切需求。国内零部件厂商积极加大研发力度，加强产业链协同攻关，已经在多个领域实现关键突破，目前成熟制程基本实现覆盖，先进制程国产化率持续提升。随着自主可控战略持续深化，叠加本土晶圆厂扩产带来的需求红利，国产半导体精密零部件制造有望加速技术迭代与市场渗透。未来，行业将向“材料自主化、工艺高端化、交付一体化”升级，推动全球市场格局重塑。

## （三）公司所处的行业地位

在集成电路装备领域，公司已构建 8-12 英寸半导体大硅片核心装备的全产业链布局，产品质量达国际先进水平，国内市占率领先；同时，延伸至芯片制造与封装环节，成功布局 8-12 英寸硅常压外延、8-12 英寸减压外延设备及减薄设备等，相关产品取得市场认可并实现批量销售。在化合物半导体装备领域，公司 6-8 英寸碳化硅外延设备、氧化炉、激活炉实现国产替代，市占率行业领先。在新能源光伏装备领域，公司取得了行业认可的技术和规模双领先的地位，具备硅片端、电池端以及组件端全产业链核心装备供应能力，全自动单晶硅生长炉市占率国际领先。在半导体衬底材料领域，公司蓝宝石衬底材料技术和规模全球领先；6-8 英寸碳化硅衬底材料技术及规模处于国内前列，量产的 6-8 英寸碳化硅衬底核心参数指标达到行业一流水平。在半导体耗材及零部件领域，公司半导体用石英坩埚技术和规模国内领先，半导体大尺寸合成石英坩埚实现国产替代；光伏石英坩埚技术和规模全球领先；大型真空腔体、大型高精度框架、精密传动主轴、磁流体、真空阀门等半导体精密零部件加工能力与量产规模处于国内前列。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	27,756,229,482.77	31,550,179,908.08	-12.03%	36,808,359,204.06
归属于上市公司股东的净资产	17,117,760,233.95	16,621,271,326.50	2.99%	14,963,146,218.89
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	11,357,487,102.93	17,576,612,657.90	-35.38%	17,983,185,712.27
归属于上市公司股东的净利润	884,734,667.29	2,509,729,984.52	-64.75%	4,557,514,076.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	617,066,500.35	2,458,544,919.99	-74.90%	4,374,890,333.95
经营活动产生的现金流量净额	738,937,931.88	1,773,443,635.01	-58.33%	3,087,793,255.29
基本每股收益（元/股）	0.68	1.92	-64.58%	3.49
稀释每股收益（元/股）	0.68	1.92	-64.58%	3.49
加权平均净资产收益率	5.26%	15.97%	-10.71%	35.56%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,137,803,861.66	2,661,147,242.69	2,474,269,855.06	3,084,266,143.52
归属于上市公司股东的净利润	572,898,649.50	66,107,650.53	262,097,276.52	-16,368,909.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	497,470,426.55	38,186,303.37	218,854,910.61	-137,445,140.18
经营活动产生的现金流量净额	395,030,756.73	51,814,182.92	-67,102,008.48	359,195,000.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,027	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	81,635	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称		股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况			
						股份状态	数量		
绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司		境内非国有法人	47.39%	620,635,522		不适用	-		

香港中央结算有限公司	境外法人	3.39%	44,358,460		不适用	-
邱敏秀	境内自然人	2.91%	38,172,420	28,629,315	不适用	-
曹建伟	境内自然人	2.72%	35,587,266	26,690,449	不适用	-
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	其他	1.27%	16,691,432		不适用	-
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.89%	11,663,857		不适用	-
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83%	10,890,695		不适用	-
毛全林	境内自然人	0.81%	10,636,476	7,977,357	不适用	-
何俊	境内自然人	0.65%	8,470,176	6,352,632	不适用	-
浙江大晶创业投资有限公司	境内非国有法人	0.59%	7,725,000		不适用	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司为公司控股股东，其实际控制人为邱敏秀女士和曹建伟先生，邱敏秀女士和曹建伟先生亦为本公司实际控制人和一致行动人，何俊先生与邱敏秀女士为母子关系，系公司实际控制人的一致行动人。除上述股东外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联或一致行动关系。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

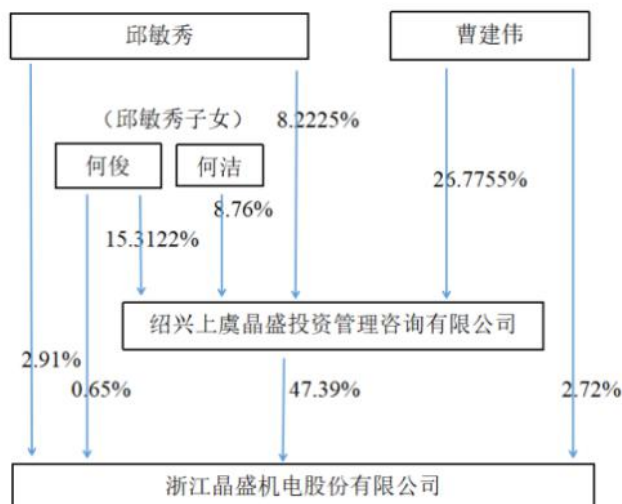
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### 三、重要事项

报告期内，公司实现营业收入 1,135,748.71 万元，归属于上市公司股东的净利润 88,473.47 万元。受光伏行业周期性调整影响，公司光伏设备和材料收入及盈利同比下滑。受益于半导体行业持续发展及国产化进程加快，公司半导体业务持续发展。报告期内，公司集成电路与碳化硅相关的设备及材料收入 18.50 亿元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未完成集成电路及化合物半导体装备合同超 37 亿元（含税）。

#### （1）深化半导体装备国产替代，持续扩大市场规模

报告期内，公司依托半导体装备国产替代的行业发展趋势和机遇，积极推进半导体装备的市场推广。在集成电路装备领域，积极推进 12 英寸干进干出边抛机、12 英寸双面减薄机等新产品的客户验证；成功开发应用于先进封装的超快紫外激光开槽设备，填补国内高端紫外激光开槽技术领域的空白，实现国产替代。发布方形硅片全流程解决方案，为客户提供效率更高、综合成本更优的一站式设备解决方案。公司自主研发的 12 英寸常压硅外延设备实现小批量销售，其电阻率、厚度均匀性、外延层缺陷密度、生产效率以及工艺重复性等关键指标达到国际先进水平。12 英寸硅减压外延生长设备顺利实现销售出货，并取得重要客户复购，在先进制程、特色硅光工艺上均取得突破。设备采用单温区、多温区闭环控温模式，结合多真空区间精准控压技术，确保外延生长过程的高度稳定性，其独特的扁平腔体结构和多口分流系统设计，能够显著提升外延层的膜厚均匀性和掺杂均匀性，满足先进制程的高标准要求。

在化合物半导体装备领域，公司紧抓碳化硅产业链向 8 英寸切换的行业发展趋势，充分发挥在碳化硅产业链装备的核心技术优势，加强 8-12 英寸碳化硅外延设备以及减薄设备的市场推广，顺利取得客户订单；积极推进碳化硅氧化炉、激活炉以及离子注入等设备的客户验证，相关设备的验证进展顺利，为规模化量产奠定坚实基础。

在新能源光伏装备领域，公司持续加强研发技术创新，在产品技术和工艺、自动化和智能化以及先进制造模式等领域持续进行创新，聚焦 TOPCon 提效与 BC 技术创新，持续完善金属腔、管式、板式三大平台设备体系，积极推进 EPD、LPCVD、PECVD、PVD 以及 ALD 等设备的市场推广和客户验证，EPD 设备持续强化行业领先的技术和规模优势，在推动产业创新的同时，助力公司高质量发展。

#### （2）加速半导体衬底材料产业化，提升全球化供应能力

报告期内，公司以碳化硅衬底为核心，实现从技术突破到规模化供应的关键跨越。公司基于自主研发的碳化硅单晶生长炉以及持续迭代升级的 8-12 英寸长晶工艺，经过多年的技术攻关，创新晶体生长温场设计及气相原料分布工艺，攻克 12 英寸碳化硅晶体生长中的温场不均、晶体开裂等核心难题，实现了 12 英寸超大尺寸晶体生长的技术突破，成功建设 12 英寸碳化硅衬底加工中试线，并基于下游应用，向产业链客户进行送样验证。同时，积极推进 8 英寸碳化硅衬底在全球的客户验证，送样客户范围大幅提升，产品验证进展顺利，并成功获取海内外客户的批量订单。公司基于全球碳化硅产业的良好发展前景和广阔市场，在马来西亚槟城投建 8 英寸碳化硅衬底产业化项目，在银川投建 8 英寸碳化硅衬底片配套晶体项目，形成“国内+海外”双产能布局，全球供应保障能力大幅提升。同时，光学级碳化硅材料布局成效显著，8 英寸产品工艺稳定并实现规模量产，12 英寸光学级碳化硅衬底研发取得突破并小批量生产。

蓝宝石材料受益于 LED 二次替换、Mini/Micro LED 新应用拓展及消费电子复苏，实现同比稳健增长；氮化硅陶瓷材料实现重大突破，成功突破了关键流延成型、精密温场控制等全产业链核心技术，首条氮化硅陶瓷基板产线正式通线量产，产品微观结构均匀性、热导率等核心指标对标国际顶尖水平，成功打破国外企业垄断，为新能源汽车、高端装备等领域提供关键材料支撑，降低下游产业进口依赖度。

#### （3）强化半导体零部件自主可控，技术实力与产业规模持续提升

报告期内，子公司晶鸿精密坚持以核心零部件国产化为目标，不断强化精密加工、特种焊接、组装测试、半导体级表面处理等核心制造能力，持续加强关键零部件的研发攻关和产业化建设，产品质量持续提升，产品品类日益丰富。强化零部件产品的市场拓展，聚焦客户需求，构建研发、制造、服务一体化解决方案，为客户提供高品质、高效率的产品和服务，提升半导体产业链关键零部件的配套供应和服务能力，公司不断拓展真空腔体、精密传动主轴、游星片、陶瓷盘以及其他高精度零部件等系列产品的客户群体，推动市场规模持续提升。

#### （4）加强组织人才建设，夯实组织管理发展基石

报告期内，公司面对半导体行业发展机遇与光伏行业周期性挑战，持续加强管理体系及组织人才建设，大力培养青年骨干人才，锻造一支善于聚焦重点任务、精准响应市场变化、勇于担当作为的复合型青年人才队伍。同时，加速高能

级技术研发平台建设，实现集团内外创新资源精准配置，强化技术、人才与产业链的深度协同，构建高效、敏捷、坚韧的组织生态，为突破“卡脖子”技术、推进核心装备与材料自主可控、加速全球化战略布局提供了坚实的人才与组织保障。

#### **（5）完善内部控制体系，提升规范治理水平**

报告期内，公司持续健全内部控制体系，结合各业务板块发展特点，系统梳理并优化内控流程。由内部审计、流程管理、财务管理等专业人员定期开展内控制度审查与评估，根据业务发展变化及监管要求，及时修订完善相关制度。在财务管理方面，强化预算管理、成本管控与资金监管，保障财务运行稳健规范；在内部审计方面，加大审计力度，拓宽审计覆盖范围，强化对业务活动的全过程监督，及时识别、预警并整改各类风险隐患。同时，结合公司经营实际优化流程控制，加强决策层、管理层与执行层的协同联动，确保内控要求有效落地。通过全面落实内部控制，公司进一步构建科学决策机制、快速市场响应机制和完善风险防范体系，持续提升规范运营能力与公司治理水平，为实现高质量可持续发展提供坚实保障。

浙江晶盛机电股份有限公司

2026 年 4 月 9 日